

## A101

A101はNIM1幅のスペクトロスコピアンブです。波形整形はアクティブフィルタ方式を採用し、理想のガウス整形に近づけております。最新の低雑音FETを利用したディスクリート増幅回路を採用しており、入力雑音特性を5 $\mu$ V以下に抑えております。アクティブゲート方式のベースラインレストアラも搭載しているので、高計数率などの測定にもご利用できます。A101は特にHPGe半導体検出器を用いた測定において、優れた分解能と直線性を実現することが可能です。

### 主な特徴

|             |  |
|-------------|--|
| ゲイン         | 1~1500倍                                      |
| 波形整形        | セミガウス整形<br>ピーキングタイム2.2 $\tau$ , パルス幅6 $\tau$ |
| 雑音特性        | 入力換算5 $\mu$ V以下 2 $\mu$ s時 ゲイン $\geq$ 100    |
| 積分非直線性      | < $\pm$ 0.05% 2 $\mu$ s時                     |
| ベースラインレストアラ | アクティブゲート方式オートスレッシュホルド                        |
| 高計数率特性      | ピークの広がり最大15% 2 $\mu$ s, 入力計数率50kcps時         |

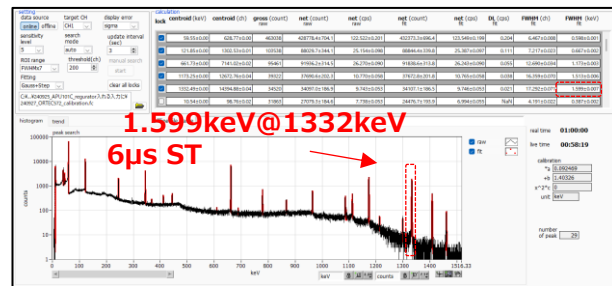
### 仕様

|              |   |
|--------------|---|
| 入力極性         | POS(正) / NEG(負)   |
| アッテネータ       | $\times$ 0.1/ $\times$ 1.0 内部基板のジャンパーにより切替                                      |
| COARSE GAIN  | $\times$ 20/ $\times$ 50/ $\times$ 100/ $\times$ 200/ $\times$ 500/ $\times$ 1K |
| FINE GAIN    | $\times$ 0.5~ $\times$ 1.5  |
| PZ ADJ       | ポールゼロ調整, 40 $\mu$ s~ $\infty$   |
| DC           | $\pm$ 40mV  |
| SHAPING TIME | 0.5/ 1/ 2/ 3/ 6/ 10 $\mu$ s   |
| 入力特性         | レンジ: $\pm$ 1.5 V, 入力インピーダンス: 1 k $\Omega$                                       |
| 出力特性         | 正極ユニポーラ 0-10V, 駆動電流 $\pm$ 100mA   |
| BUSY OUT     | TTL出力   |
| プリアンプ電源      | D-Sub9 $\pm$ 12V, $\pm$ 24V (NIM規格準拠) 内蔵  |
| 消費電力         | +12V (160mA)<br>+24V (40mA), -24V (40mA)  |
| 寸法・重量        | NIM1幅 34(W) x 221(H) x 249(D) mm,<br>約975g                                      |

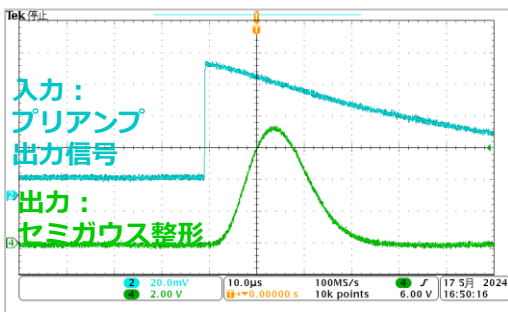
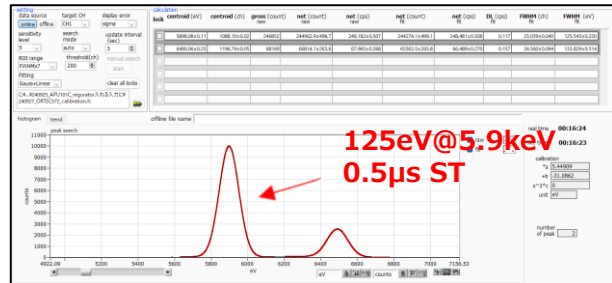


背面

### HPGe半導体検出器



### SDD (シリコンドリフト検出器)



## 株式会社テクノエーピー

〒312-0012茨城県ひたちなか市馬渡2976-15

TEL:029-350-8011 FAX:029-352-9013

[info@techno-ap.com](mailto:info@techno-ap.com)



※写真はイメージです。  
※記載内容は予告なく変更することがあります。

<https://www.techno-ap.com>

20241129

